

課題番号 : F-15-IT-0016
利用形態 : 技術相談
利用課題名(日本語) : InGaAs 薄膜形成
Program Title (English) : Formation of InGaAs thin films
利用者名(日本語) : 薬師寺 守¹
Username (English) : Mamoru Yakushiji¹
所属名(日本語) : 1) (株) 日立ハイテクノロジーズ
Affiliation (English) : 1) Hitachi High-Technologies Co.

1. 概要(Summary)

なし。

本件は当初広島大学の田部井先生に「3 インチ Si 基板上にエピタキシャル成長で InGaAs 成長で 100nm つけたい」との希望が相手側より出され、プラットフォーム内で III-V エピタキシー装置を保有する知る限り唯一の機関である東工大に依頼が来た。

そこで直接聞き取りを行い、用途はドライエッチングにおける InGaAs 膜のエッチング条件の把握であることが判明した。そこで、Si 基板上に製膜する必要はなく、基本的には InP 基板上に製膜した場合でも同じ用途で使えること、その場合は、簡単な技術代行で可能になるが InP 基板については申込側で用意いただきたいこと、数十万円だせば専門のエピベンダーから購入も可能なこと、我々の装置では 3 インチでは一般的に用いておらず、2 インチ以下で行いたいことなどを説明した。

以上に基づき、InP 基板上への InGaAs 製膜に変更になり、InP 基板の購入先なども紹介し、めどが立ったとの連絡があり、非公開を含む料金の確認を行ったが、その後実際の製膜の申込はなかった。

2. 実験(Experimental)

技術相談のため概要のみ記載、以下、空欄

3. 結果と考察(Results and Discussion)

技術相談のため概要のみ記載、以下、空欄

4. その他・特記事項(Others)

なし

5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし

6. 関連特許(Patent)